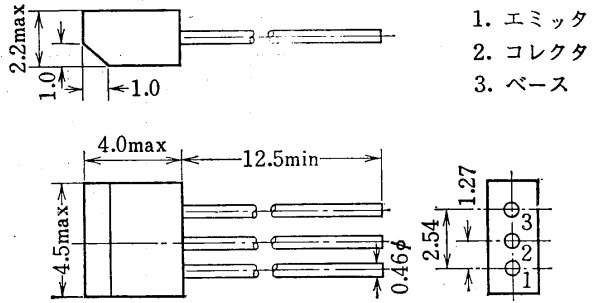


2SC535

シリコン NPN
エピタキシャルプレーナ形
FM 高周波増幅用, 周波数変換
用, 局部発振用



■ 最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

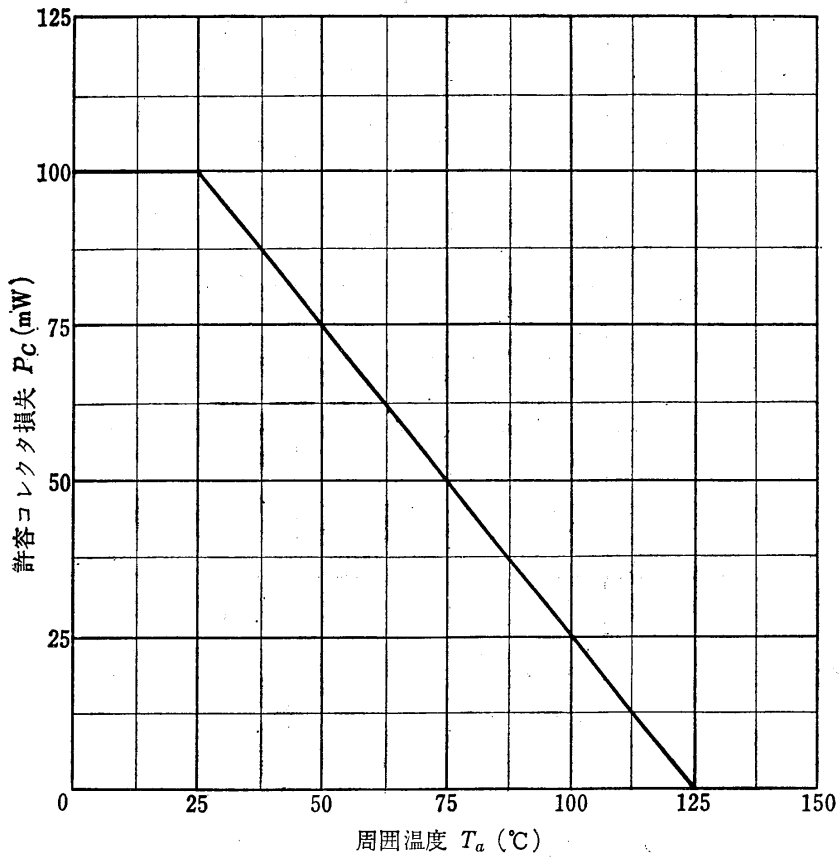
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	30	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	20	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	4	V
コレクタ電流	I_C	20	mA
許容コレクタ損失	P_C	100	mW
接合部温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+125	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

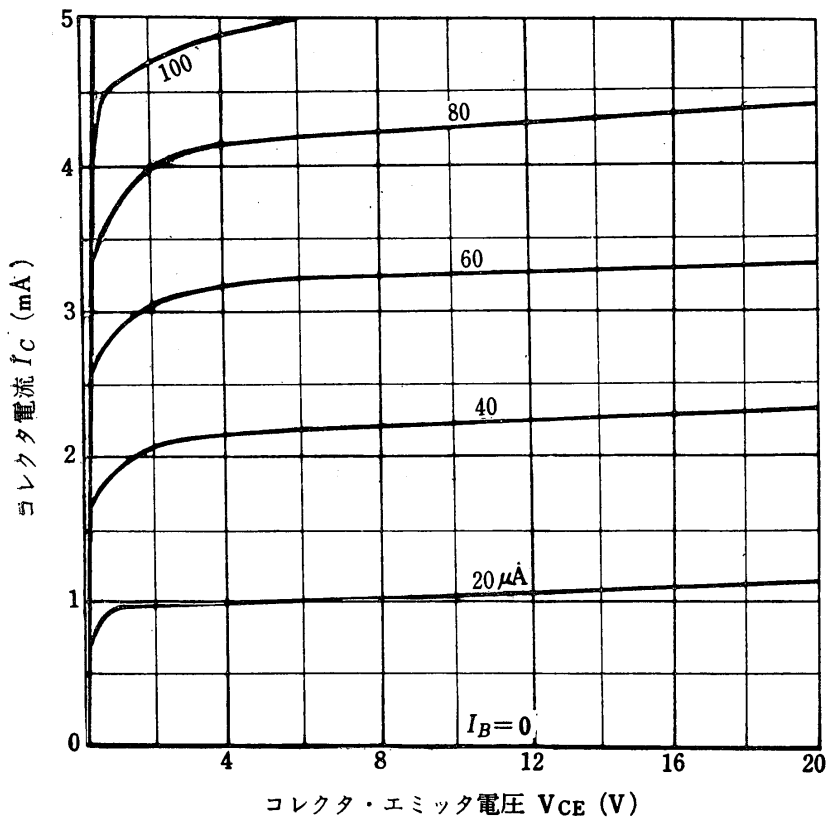
	最小	標準	最大	
コレクタ・ベース破壊電圧 BV_{CBO} ($I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$)	30	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧 BV_{CEO} ($I_C=1\text{mA}, R_{BE}=\infty$)	20	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧 BV_{EBO} ($I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$)	4	—	—	V
コレクタ遮断電流 I_{CBO} ($V_{CB}=10\text{V}, I_C=0$)	—	—	0.5	μA
直流電流増幅率* h_{FE} ($V_{CE}=6\text{V}, I_C=1\text{mA}$)	35	—	200	
ベース・エミッタ電圧 V_{BE} ($V_{CE}=6\text{V}, I_C=1\text{mA}$)	—	0.72	—	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ ($I_C=20\text{mA}, I_B=4\text{mA}$)	—	0.17	—	V
利得帯域幅積 f_T ($V_{CE}=6\text{V}, I_C=1\text{mA}$)	450	700	—	Mc
コレクタ出力容量 C_{ob} ($V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{Mc}$)	—	0.9	1.2	pF
電力利得 PG ($V_{CE}=6\text{V}, I_C=1\text{mA}, f=100\text{Mc}$)	17	20	—	dB
雑音指数 NF ($V_{CE}=6\text{V}, I_C=1\text{mA}, f=100\text{Mc}, R_g=50\Omega$)	—	3.5	5.5	dB
入力アドミタンス (標準値) y_{ie} ($V_{CE}=6\text{V}, I_C=1\text{mA}, f=100\text{Mc}$)	0.22 + j0.58			$\text{m}\Omega$
逆伝達アドミタンス (標準値) y_{re} (")	-j0.64			$\text{m}\Omega$
順伝達アドミタンス (標準値) y_{fe} (")	32 - j11.2			$\text{m}\Omega$
出力アドミタンス (標準値) y_{oe} (")	0.05 + j0.56			$\text{m}\Omega$

*2SC535 は h_{FE} の値により下記のように3区分し現品にそれぞれ (A), (B), (C) と表示してあります. (A) 35~70, (B) 60~120, (C) 100~200.

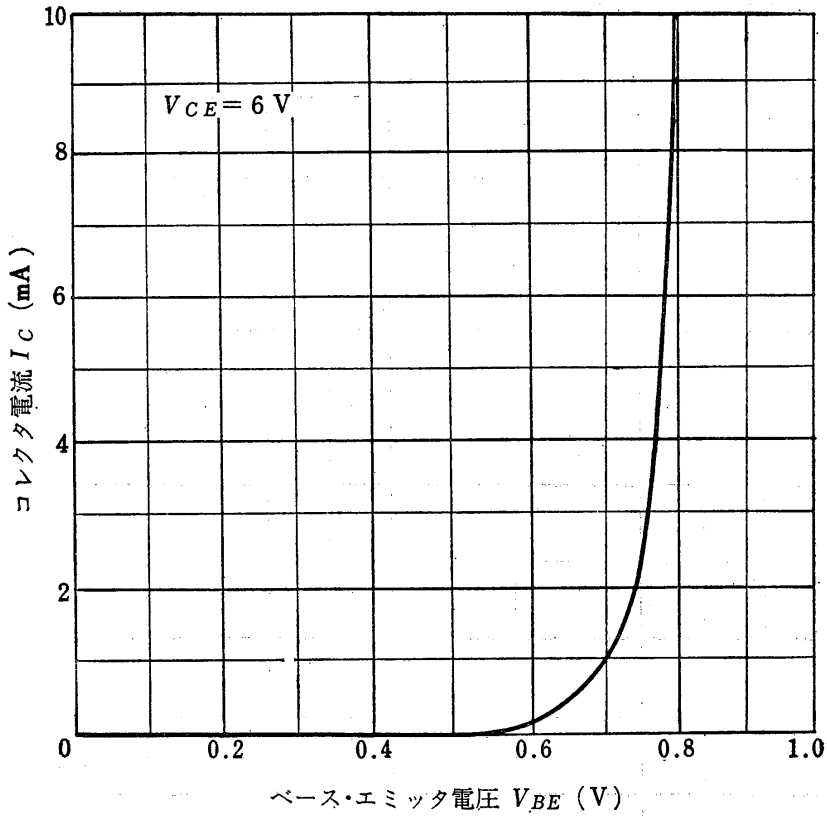
許容コレクタ損失の周囲温度による変化



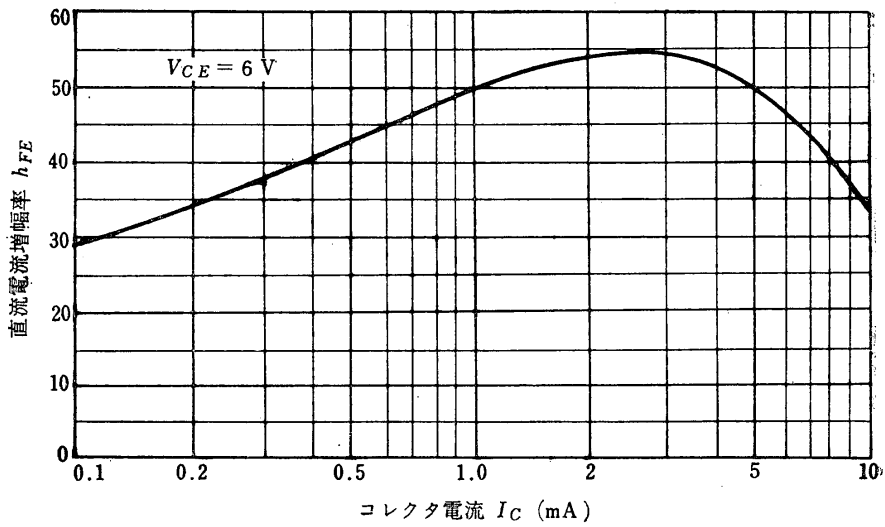
エミッタ接地出力静特性



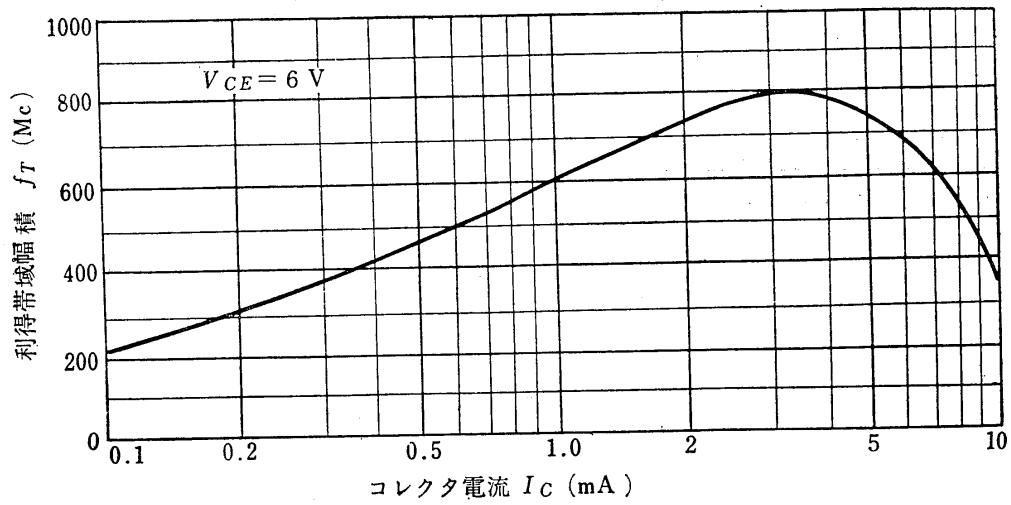
エミッタ接地伝達静特性



直流電流増幅率対コレクタ電流特性



利得帯域幅積対コレクタ電流特性



雑音指数対コレクタ電流特性

